

~~書類名~~

~~図面~~

~~図1~~

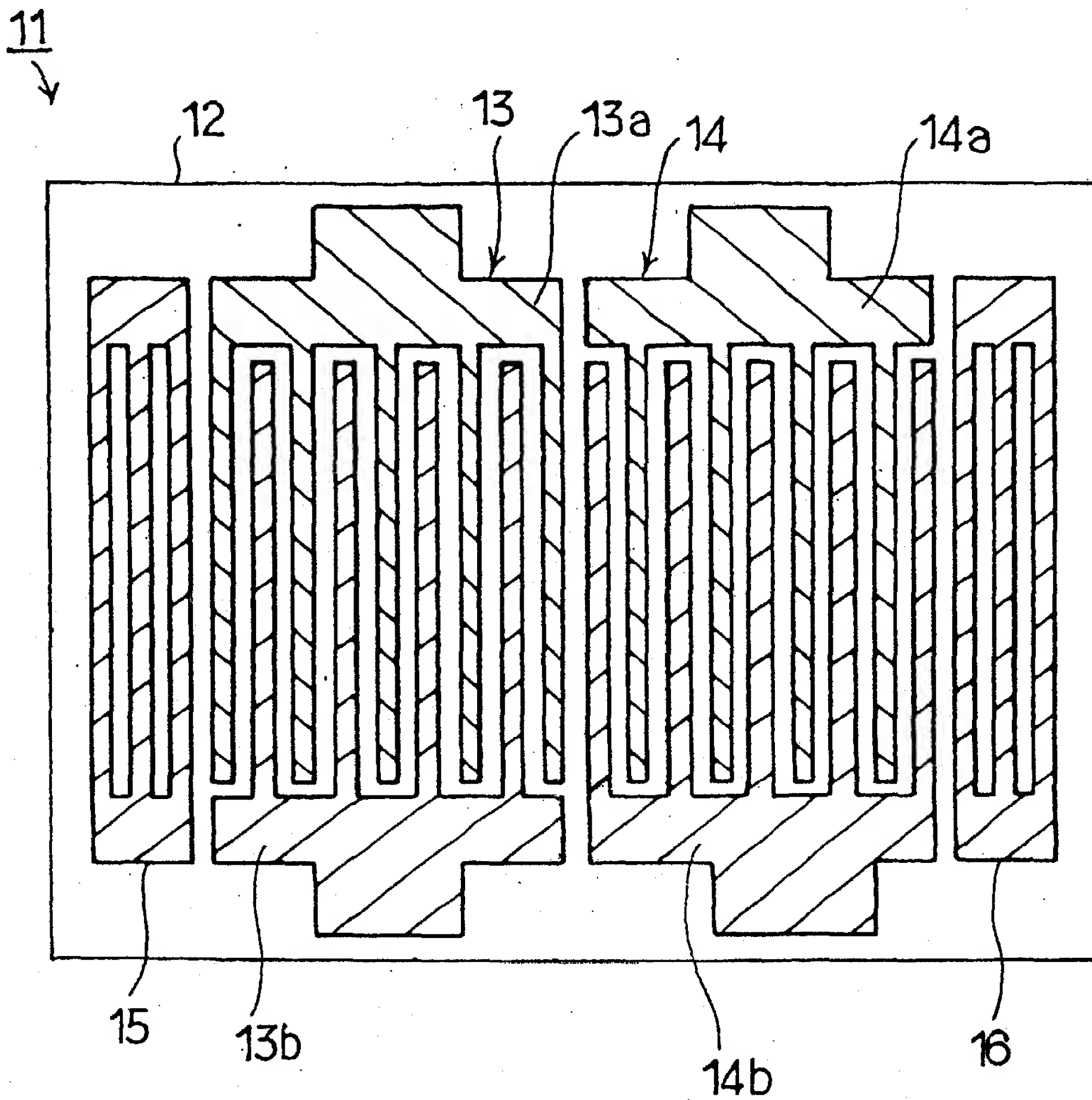


FIG. 1

特許庁 特許第 329341 号

~~(a)~~ METALLIZATION RATIO

~~メタライゼーションレオ=0.75~~  $h/\lambda 1.8\%$ 

~~(b)~~ METALLIZATION RATIO

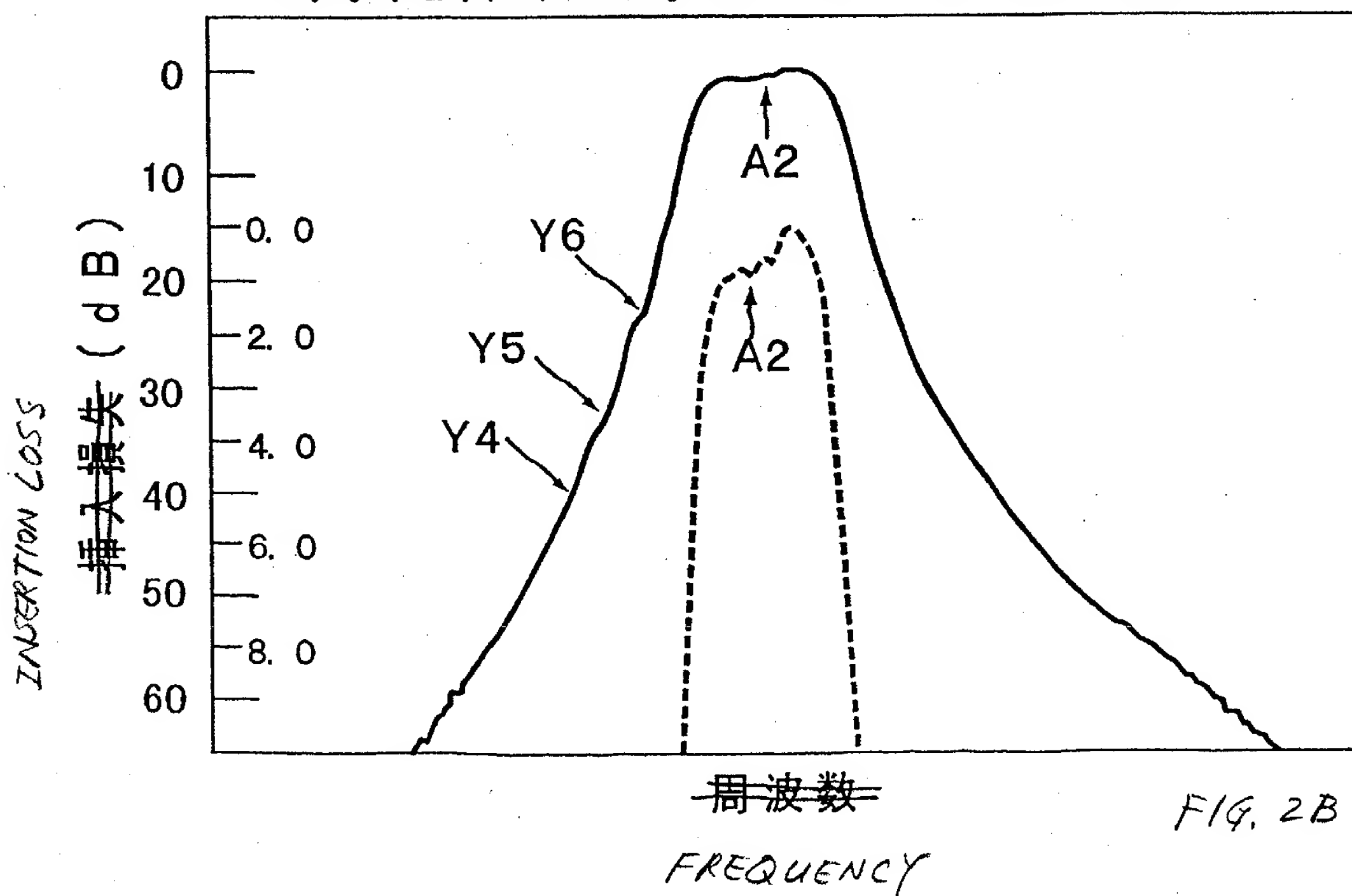
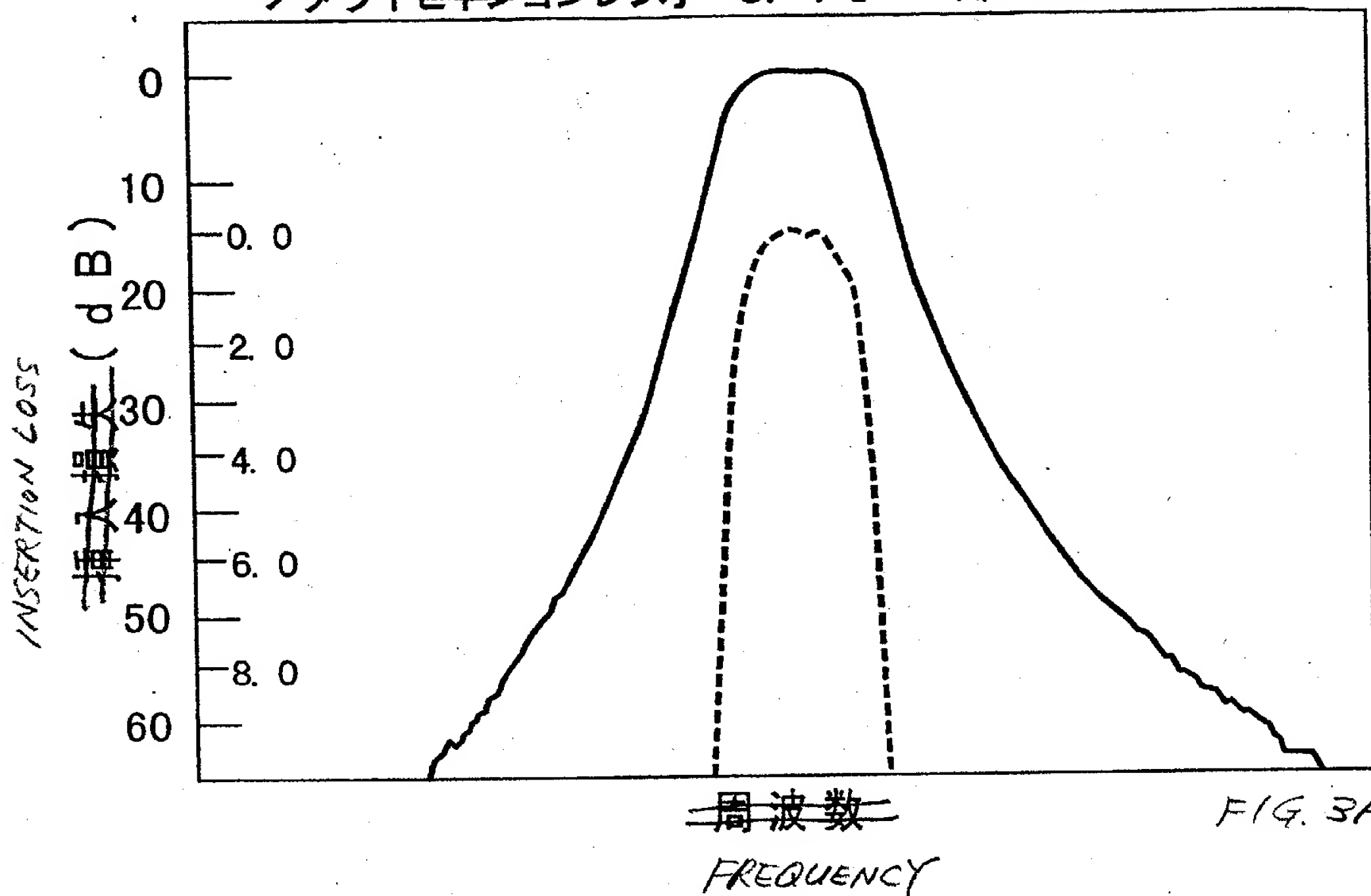
~~メタライゼーションレシオ~~ = 0.75    ~~h/λ~~ 2.0%

FIG. 2B

~~図3~~

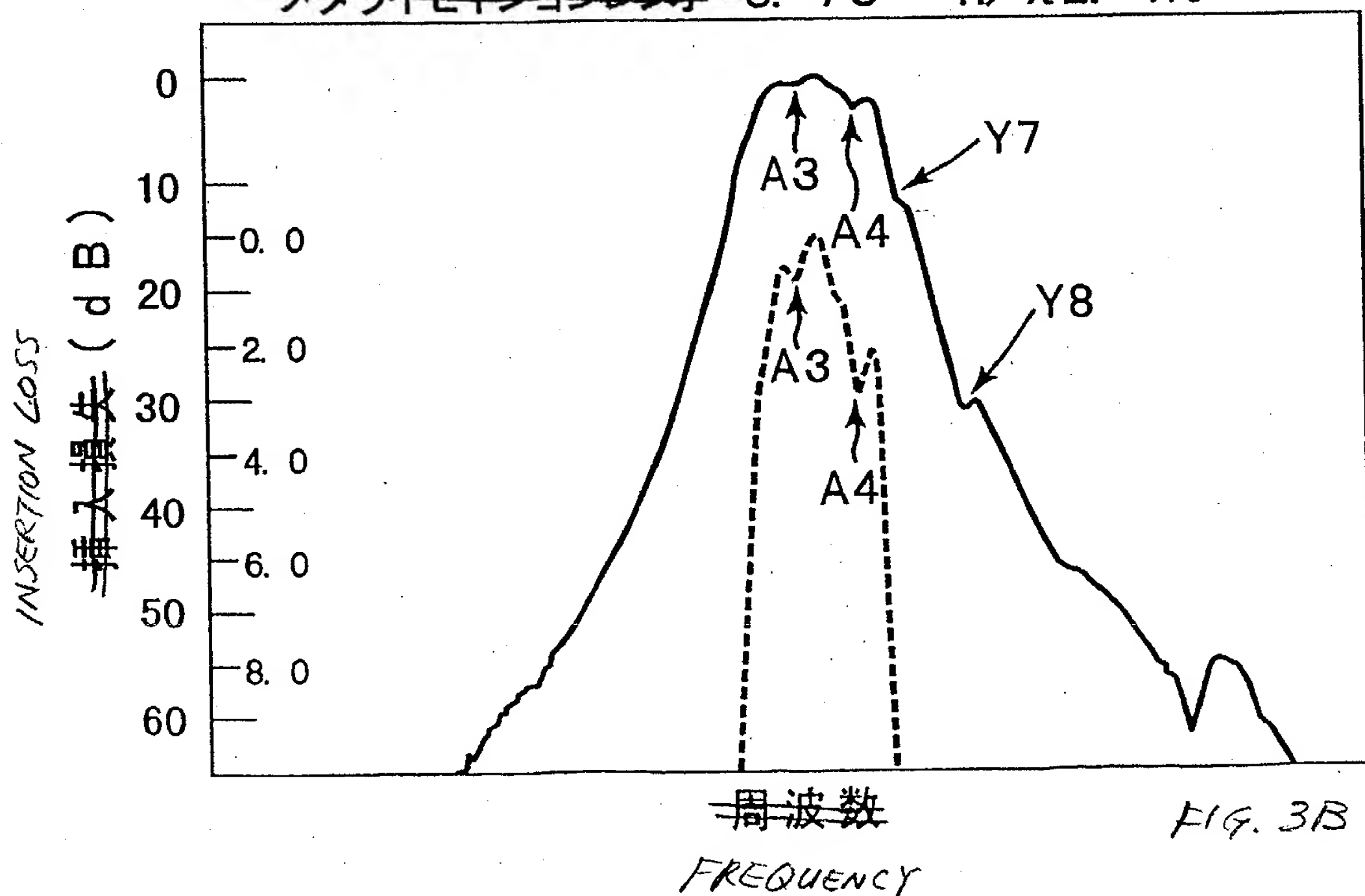
~~(a)~~ METALLIZATION RATIO

~~メタライゼーションレシオ~~ = 0.75  $h/\lambda$  2.2%



~~(b)~~ METALLIZATION RATIO

~~メタライゼーションレシオ~~ = 0.75  $h/\lambda$  2.4%



70260 TEH9660

ANISOTROPIC INDEX AT  $T_a$ /CRYSTAL

METALLIZATION RATIO

~~$T_a$ /水晶の異方性指数~~ ~~対ラミネーション~~  $= 0.75$

整理番号=DP000181

提出日 平成12年10月27日  
特願2000-329341 頁: 4/ 12

~~【図4】~~

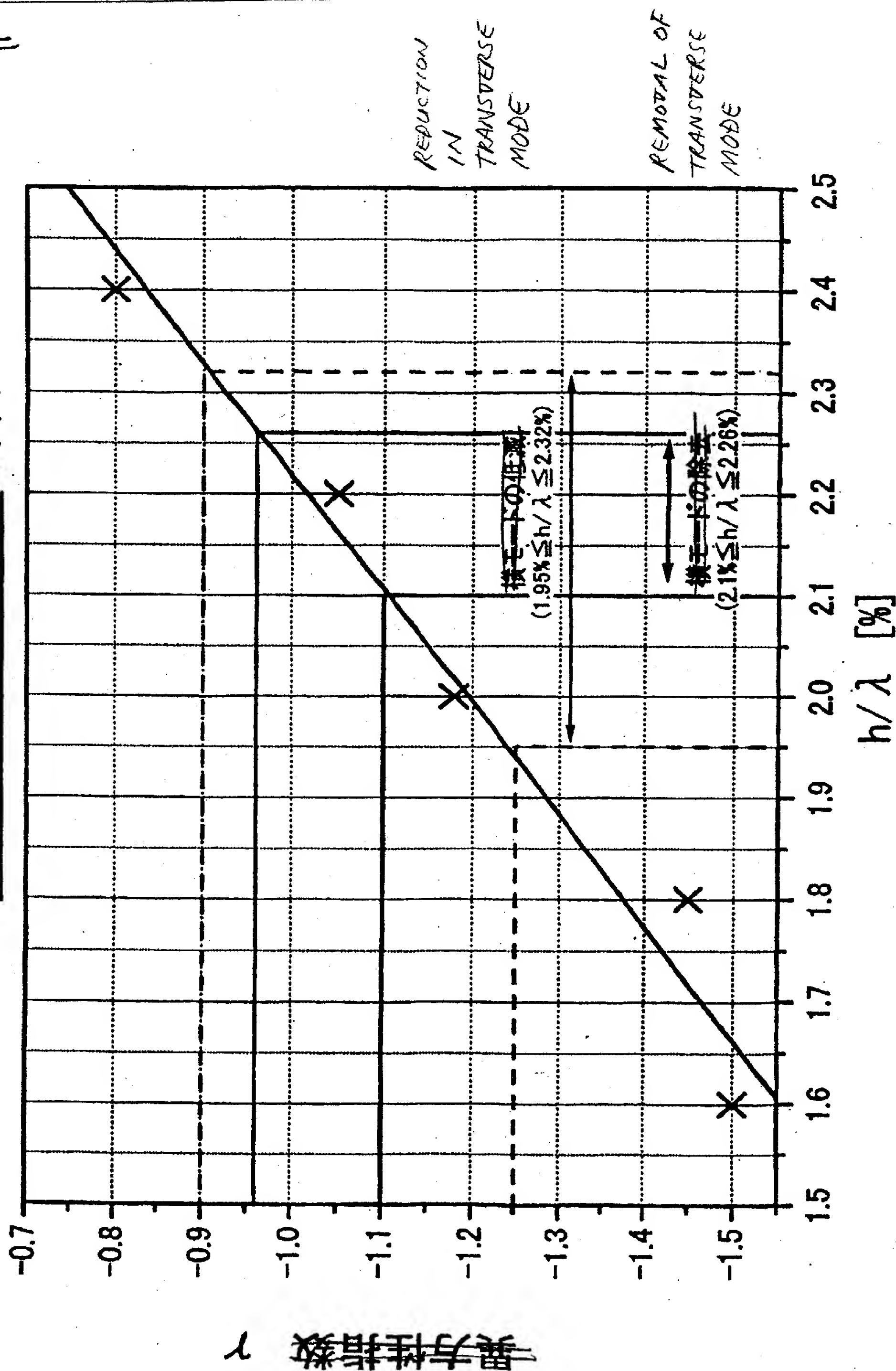


FIG. 4

FD/260" FEB 1960

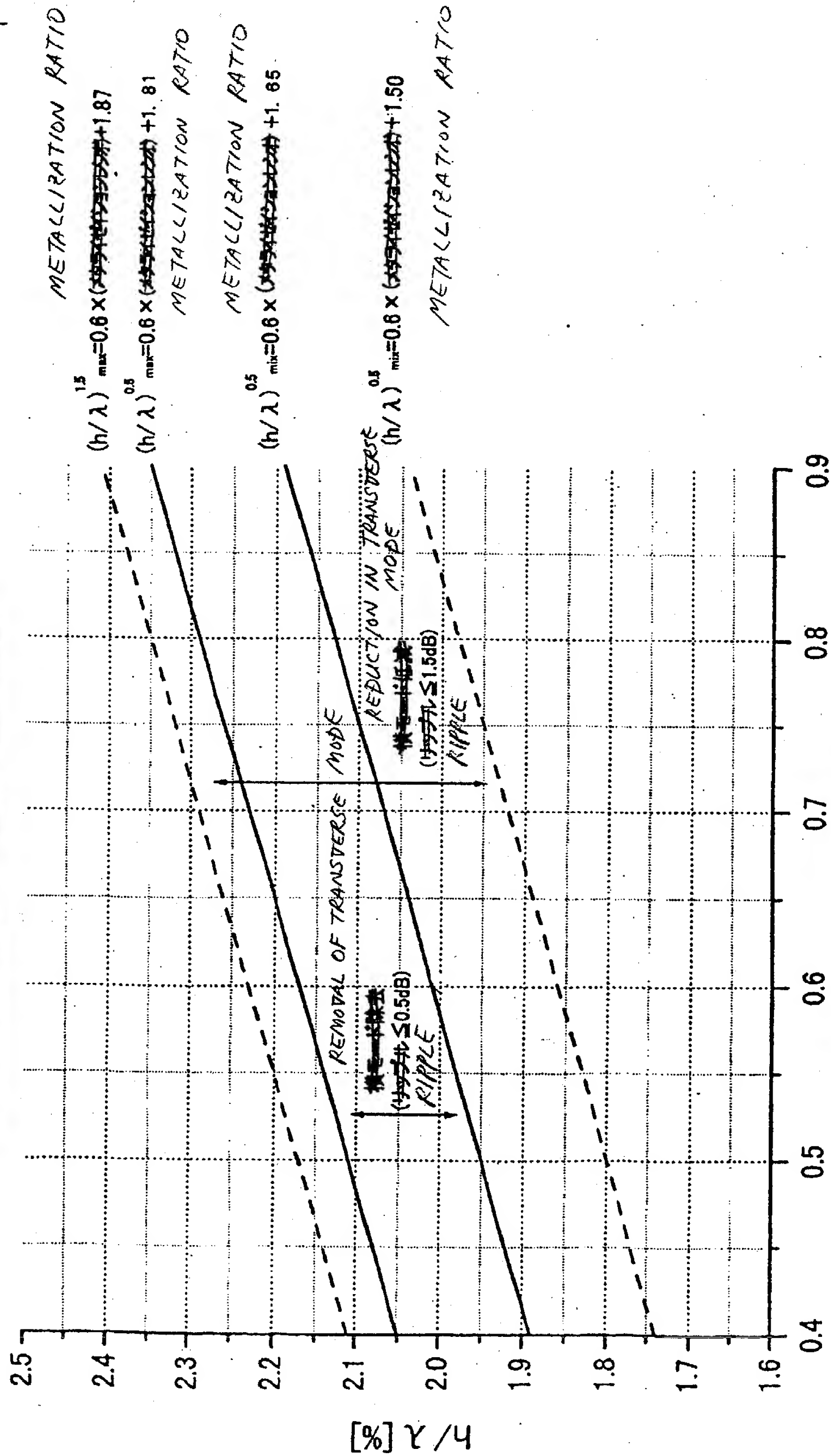
RANGE WHERE RIPPLE CAUSED BY TRANSVERSE-MODE WAVE CAN BE REDUCED

整理番号=DP000181

提出日 平成12年10月27日  
特願2000-329341 頁: 5/ 12

~~図5~~

横モードによるリップルの低減可能な範囲

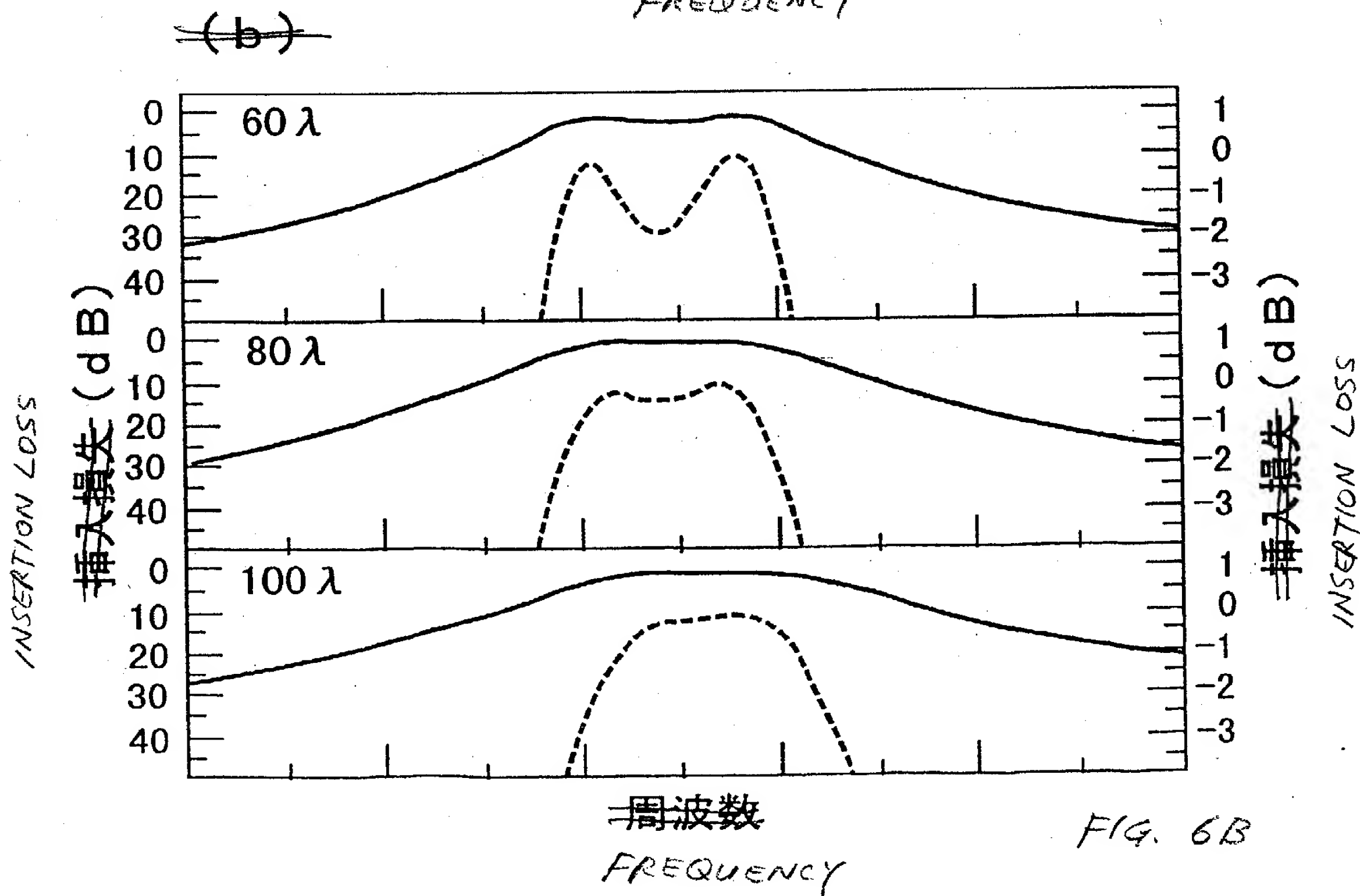
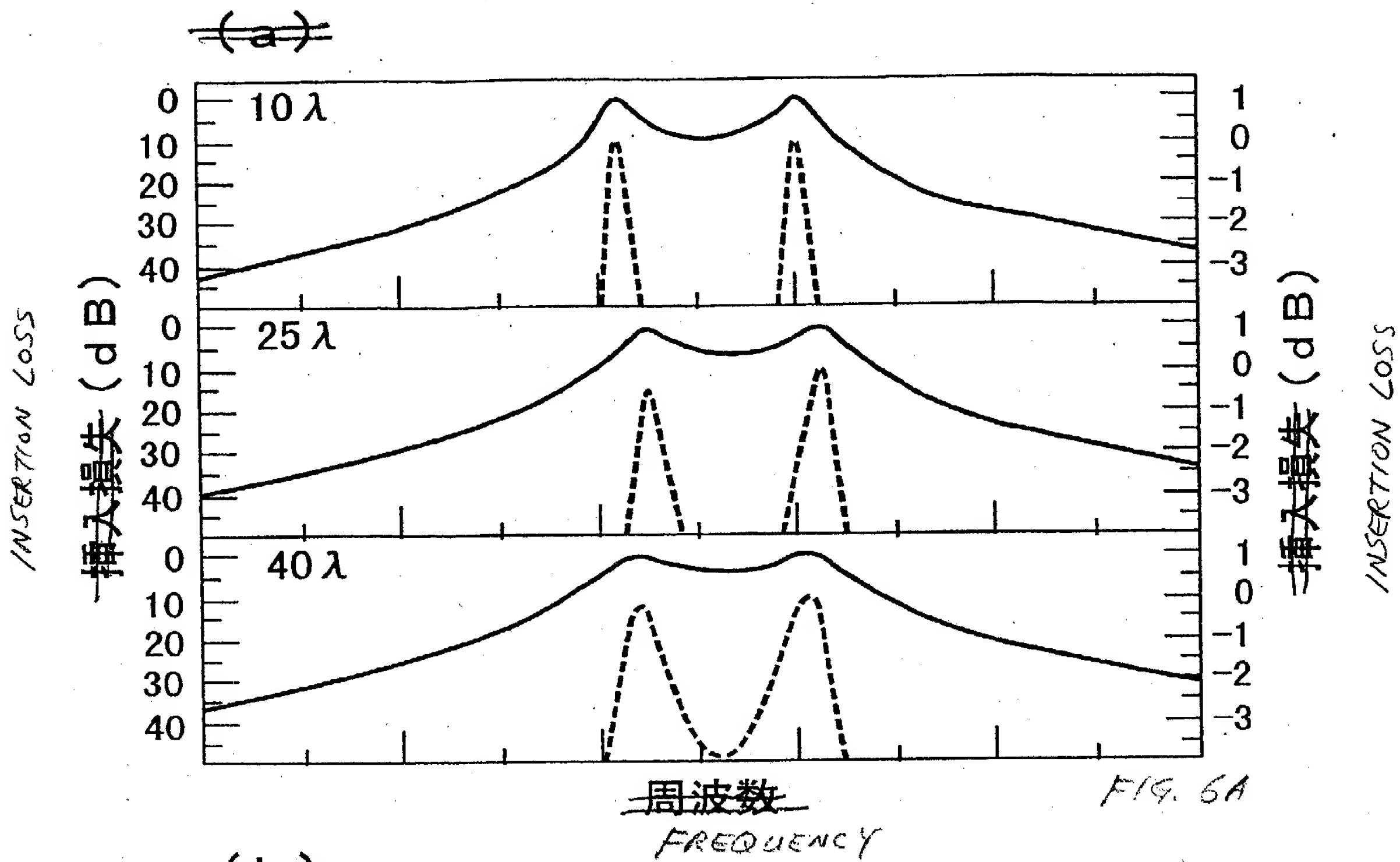


横モードによるリップルの低減可能な範囲

METALLIZATION RATIO

FIG. 5

【図6】



特許庁 特許第 329341 号

整理番号=DP000181

提出日 平成12年10月27日  
特願2000-329341 頁: 7/ 12

~~図7~~

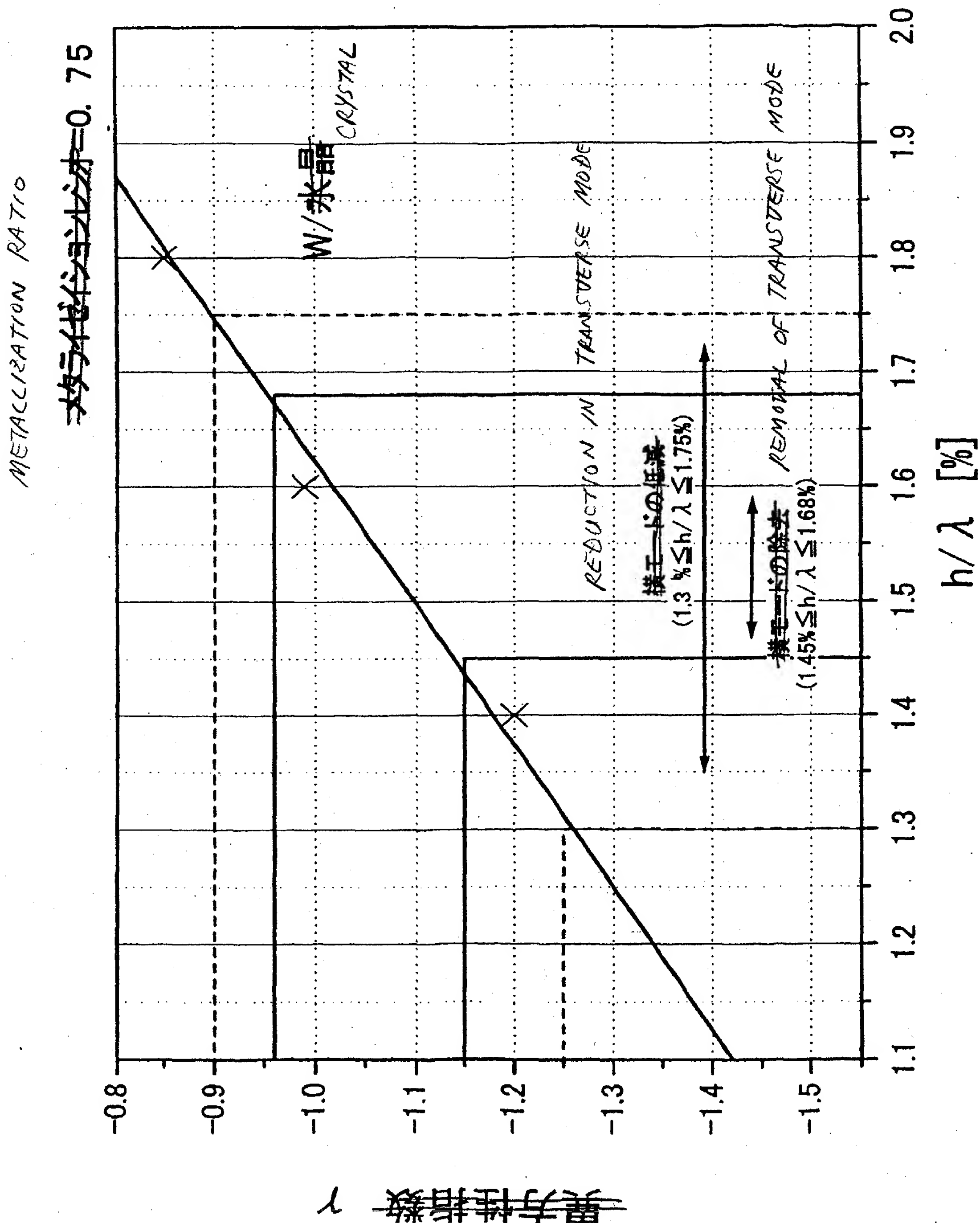


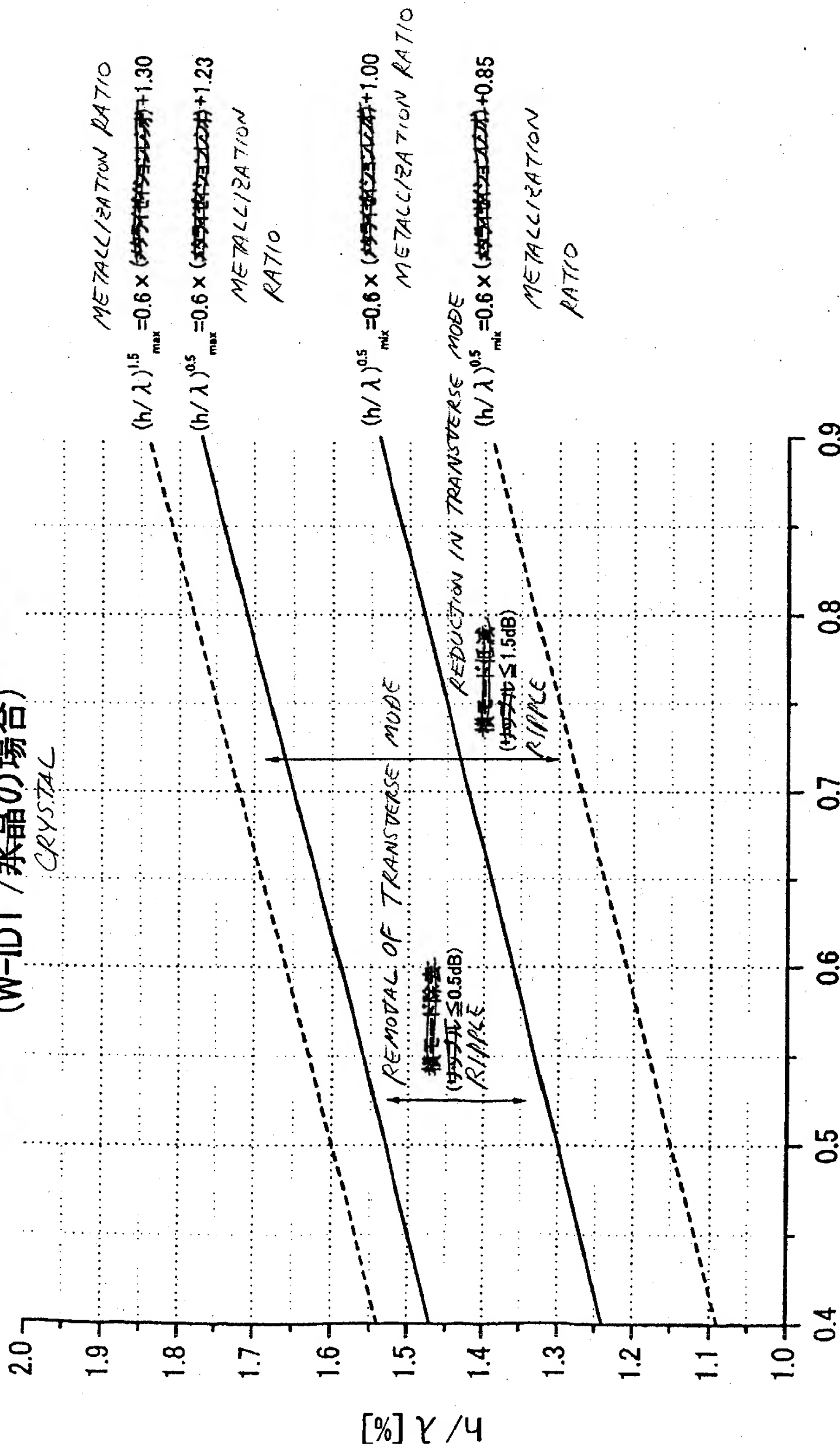
FIG. 7



RANGE WHERE RIPPLE CAUSED BY TRANSVERSE-MODE WAVE  
CAN BE REDUCED

~~横モードによるリップルの低減可能な範囲~~

(W-IDT / 水晶の場合)  
CRYSTAL



~~クラセイション法~~

METALLIZATION RATIO

FIG. 8



~~図9~~

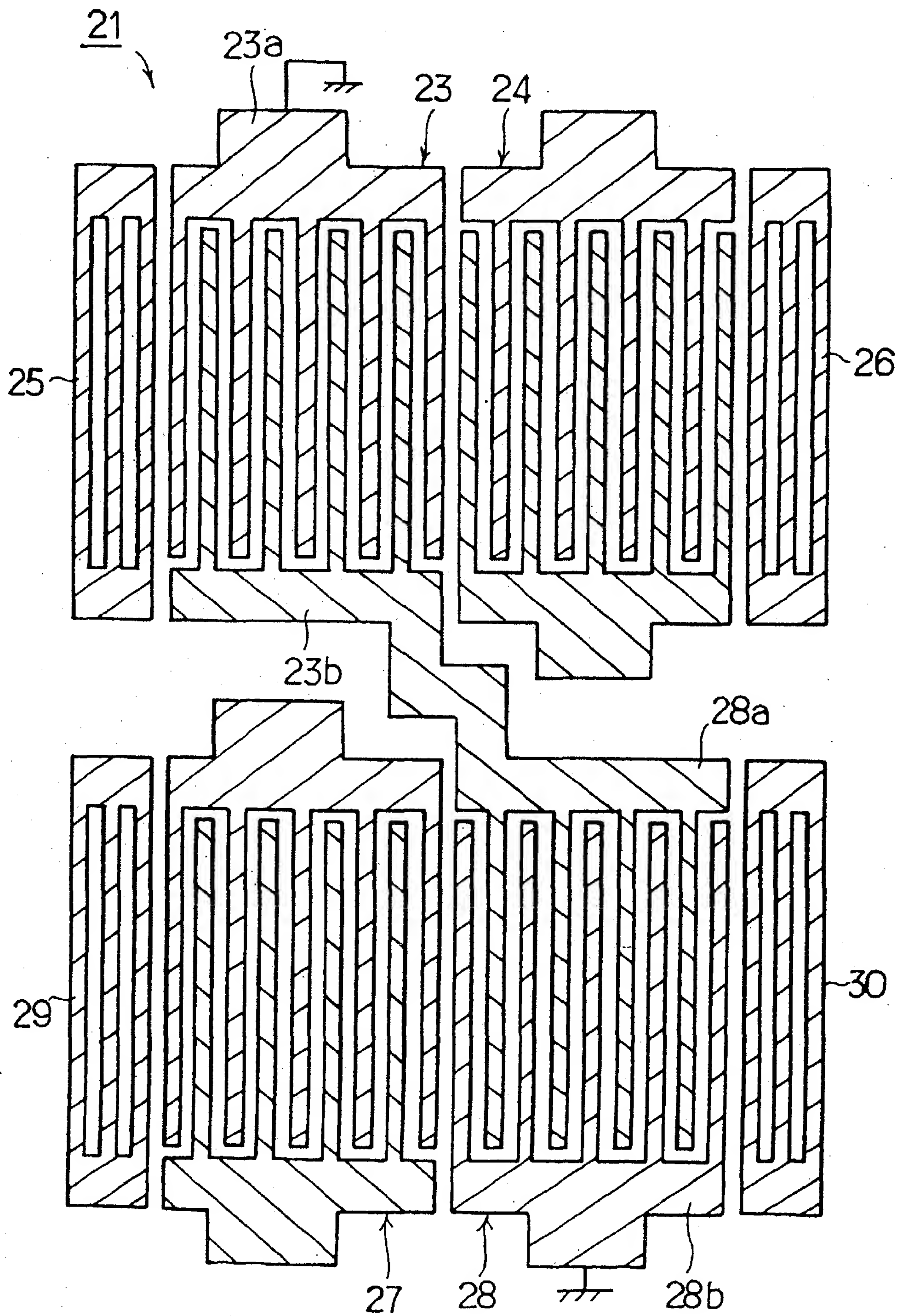


FIG. 9

特許庁登録第 349650 号

~~【図10】~~

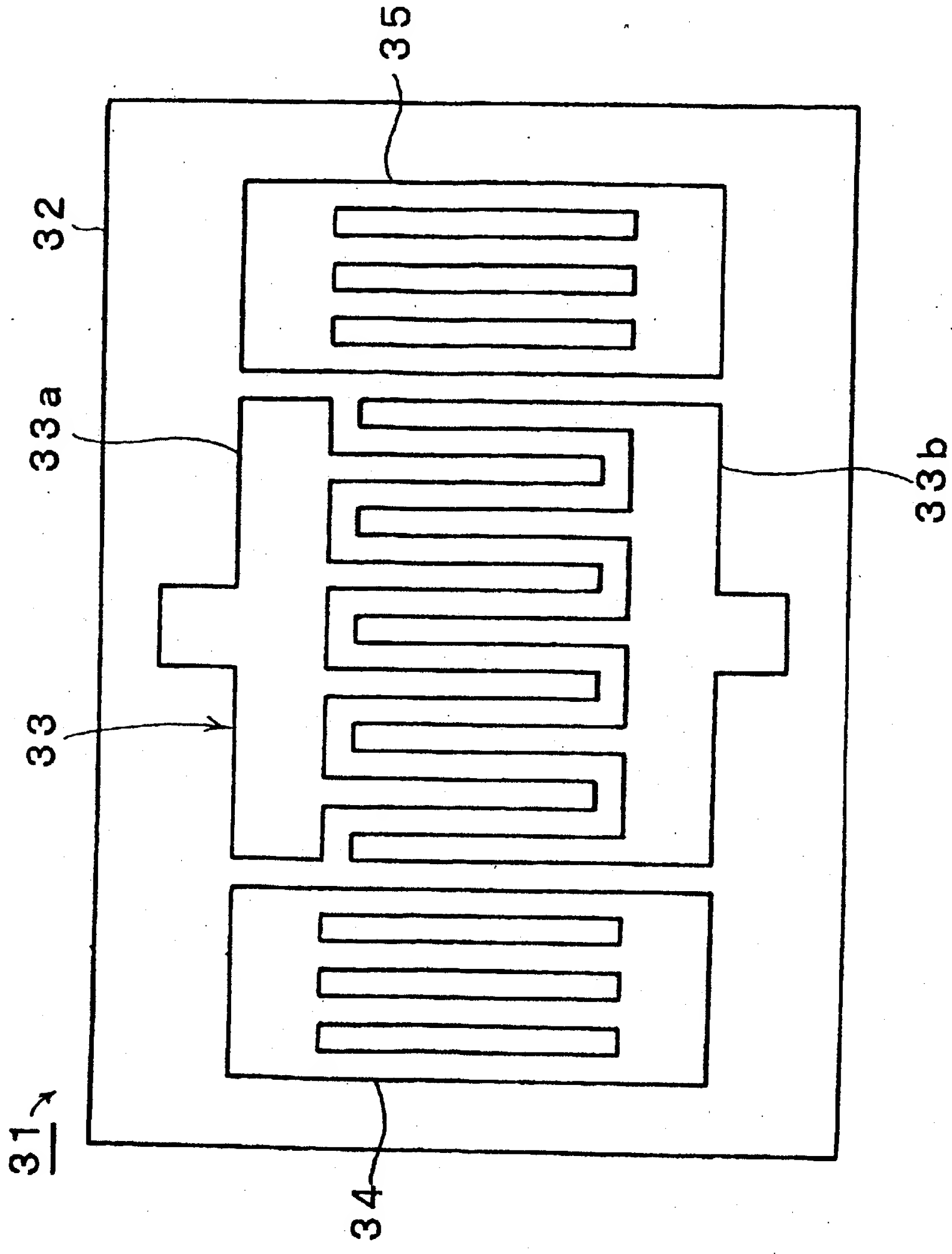


FIG. 10

~~【図11】~~

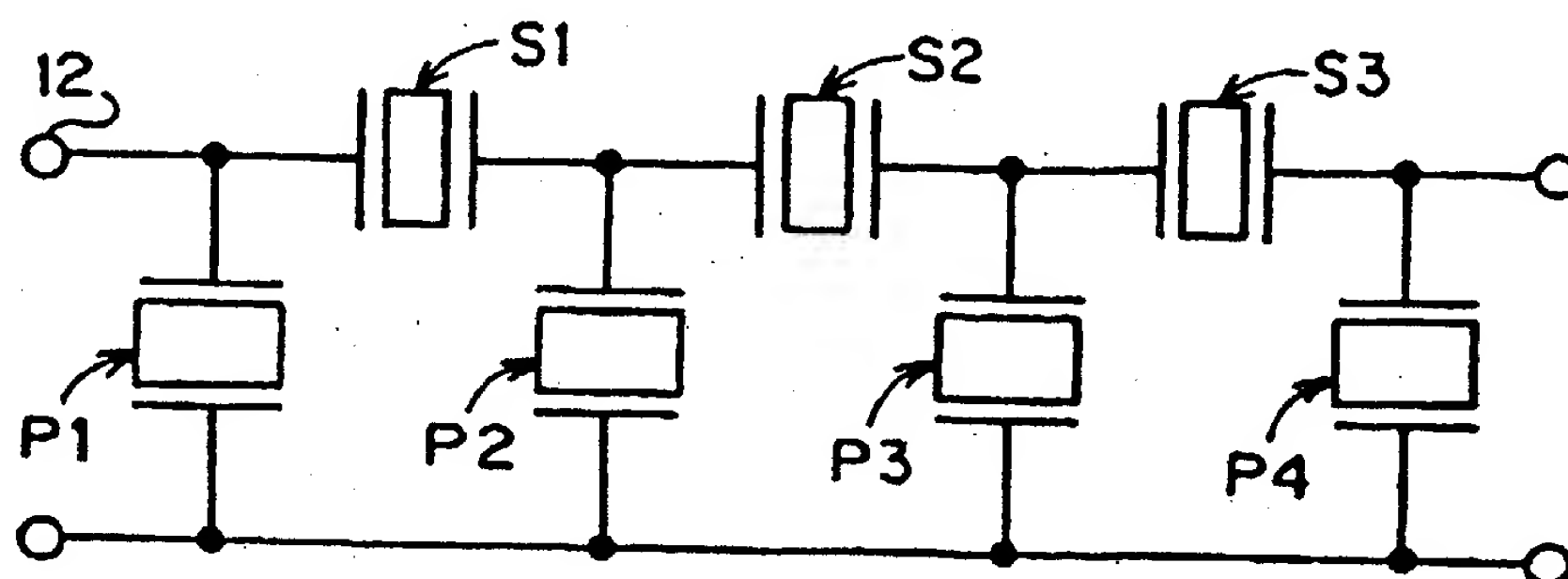


FIG. 11

~~【図12】~~

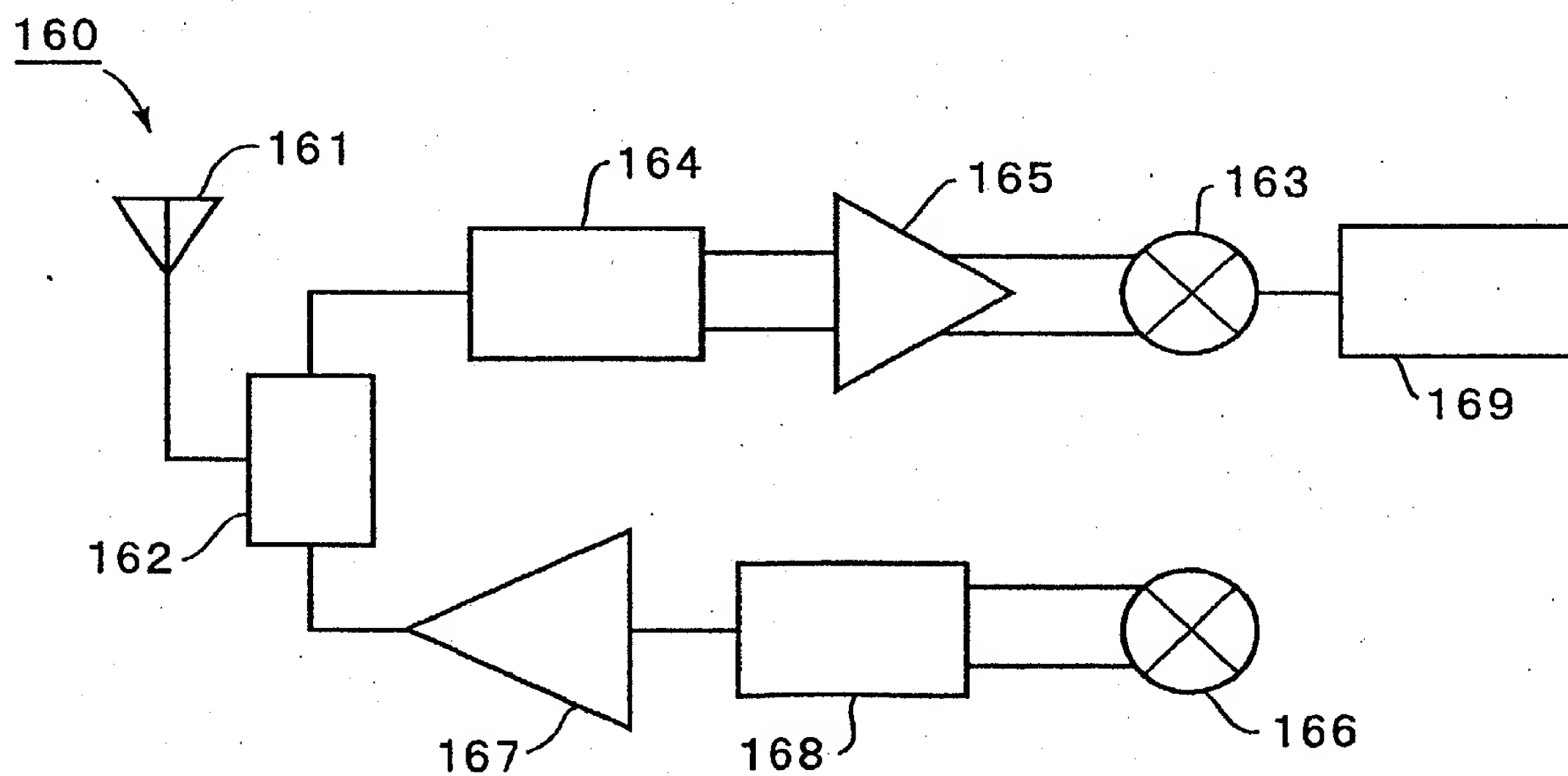


FIG. 12

10/22/2000 12:49:56

~~【図13】~~

METALLIZATION RATIO

~~メタライゼーション比~~ = 0.75  $h/\lambda$  2.50%

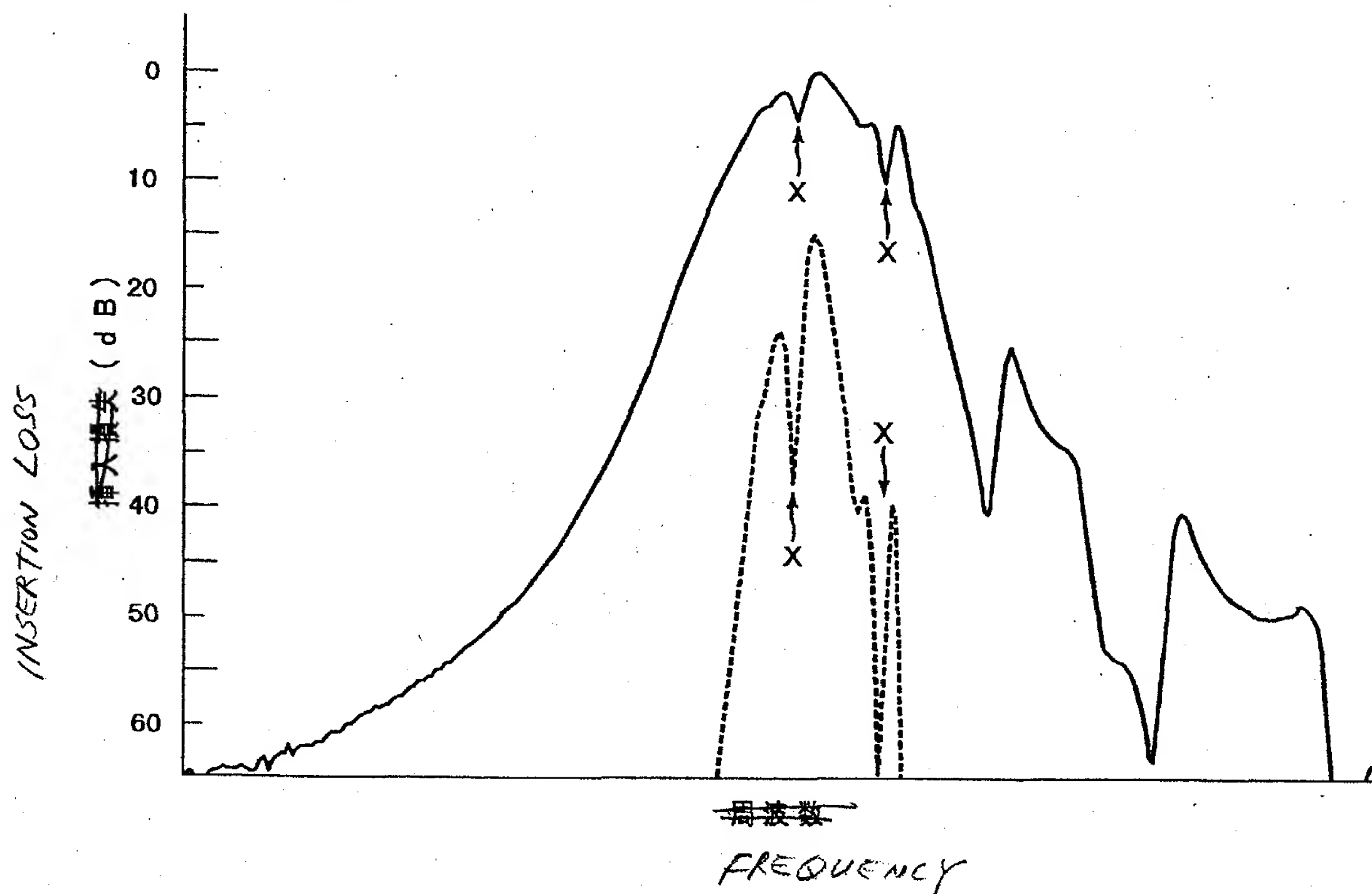


FIG. 13